



「すざく」衛星搭載 硬X線検出器(HXD) 主検出部の現状 IV

西野 翔(広島大学)

深沢泰司、高橋弘充、水野恒史、林克洋、平木一至(広島大学)、山田真也、 中澤知洋、湯浅孝行、鳥居俊輔(東京大学)、国分紀秀、渡辺伸(ISAS/JAXA)、 田中孝明(Stanford)、川原田円(理研)、寺田幸功(埼玉大学)、すざくHXDチーム

天文学会 2010/03/27 @広島大学

話す内容

- ・イントロダクション
 - すざく衛星 硬X線検出器 (HXD)
- PINキャリブレーションの現状
 ノイズイベントの経年変化
 (軌道上/ 地上での対策)
- ・GSOキャリブレーションの現状
 - エネルギー較正
 - ゲイン変動のモデル化
 - New Response/Background

すざく衛星 硬X線検出器 (HXD)



徹底したバックグラウンド除去により、 硬X線帯域において、最高感度を達成 HXDは、打ち上げから4年半が 経過した現在も、重大なトラブル はなく、全てのユニットで正常に 動作している

PIN: ノイズイベントの経年変化(軌道上)



各観測のPINカウントレート(W32)



時間経過ともに、ノイズイベントが増加 (軌道上における放射線損傷)

機上アナログ/デジタルのデータ処理系において、 イベントの飽和が起きており、不感時間が増加

PIN: ノイズイベントの経年変化(軌道上)





時間経過ともに、ノイズイベントが増加 (軌道上における放射線損傷)

機上アナログ/デジタルのデータ処理系において、 イベントの飽和が起きており、不感時間が増加

定期的にアナログLD、デジタルLDの 引き上げを行うことで対処

PIN: ノイズイベントの経年変化(地上)



各PINに対してpinthr(Caldb)を設け、解析に 用いるクリーンイベントに、ノイズが混入しない ようにしている

時間経過とともにノイズイベントが増加

→年に一度pinthr値をアップデート ae_hxd_pinthr_yyyymmdd.fits (CALDB)

> ~ 0.6 keV / yearで平均pinthr値が 高エネルギー側にシフト

pinthrの引き上げにより、 15 keV以下の有効面積が減少してるが、 ノイズの混入は気にせず解析できる

GSO: エネルギー較正



GSO: ゲイン変動のモデル化

軌道上における、GSOゲインの時間変動に 対応するため、GHT(Gain History Table) を作成

・長期成分のモデル化

打ち上げ後の時間の関数としてモデル化 511 keV対消滅ラインを利用

Long(t) = a + b exp(-t / c) + d exp(-t / e)

 ・短期成分のモデル化
 TSAA(SAA通過後の時間)、温度の関数 としてモデル化
 PHA(t) = Long(t) { 1 + f(TSAA) + g(温度) }
 f(TSAA) = - b exp (-TSAA / c)
 g(温度) = d + e x 温度



GSO: ゲイン変動のモデル化



GSO: New Response/BackGround

2010年4月から新しいエネルギースケール、ゲインによるプロセスを開始 ⇒ 以降のデータは、ユーザー自身がリプロセスを行う必要なし

新プロセスに対応するレスポンス/バックグラウンド ⇒現在チーム内で、確認作業中 4月より順次公開

Crab spectra



まとめ

- ・HXDは、これまで大きなトラブルなく、全ユニットで順調に観測を続けている
- ・ PIN 軌道上における放射線損傷により、時間経過とともにノイズイベントが増加
 - 機上でのイベント飽和による不感時間の増加 ⇒ 機上のアナログ/デジタルLDの引き上げオペレーションを行い対応
 - 解析に用いるクリーンイベントへのノイズ混入の影響
 ⇒地上ソフトによるthresholdを定期的にアップデートすることで対応 2010/03 ~ epoch 7/8 へ変更
- GSOのキャリブレーションをアップデート
 - エネルギースケールの見直し
 - ゲインヒストリーの精度

70 keV以上では、補正なしで解析が可能になった

過去の観測も含めて、response/background ファイルを再作成 4月から順次公開

The non linear effect of light yields in GSO Annihilation line ¹⁵¹Gd Ex). 70 keV EC \rightarrow Single y 511 keV Fluorescence **Activation lines** gamma-ray 20 keV Eu K binding E or \rightarrow Multiple γ , e or γ decay ~ 50 keV Auger e-IC e-¹⁵¹Eu 1.0 E vs. light yeilds relation of GSO 0.8 e - response Several e- or y reduces light (Uchiyama 1998) yeilds, considering all decay 0.6 probability, The correct energy are, Photon response 70 keV - 6 % (Kitaguchi 2006) 150 keV - 5 % 196 keV - 3 % 0.4 20 10 50 100 200 500

1.7

Energy



After using the satellite power, the analog offset changed by ~ 8 ch lower

PIN: Flare-like Event

- 2009/09/13

W01-P3 のカウントレートが急増

約8時間後(リモートパス中)に、 自然に収まっていたため、HV下げ などのオペレーションは行っていない

現在も注意して監視している



これまでのPINフレアの履歴

- 2006/05/24 W01-P3 Flare-like event \Rightarrow WPU0 \mathcal{O} HV 500V \rightarrow 400V
- 2006/10/03 W10-P0 Flare-like event \Rightarrow WPU1 \mathcal{O} HV 500V \rightarrow 400V
- 2007/07/28 W10-P0 Flare-like event ⇒ HV下げオペレーションにより復帰

軌道上における放射線損傷により、ブレークダウン電圧が低下していると思われる 現在は、W0/1:400V, W2/3:500Vの高圧をかけて運用中

PIN: ノイズイベントの経年変化(軌道上)



Event rate [cnts/s]

GSO: ゲイン変動のモデル化(長期成分)

- 軌道上における、GSOゲインの時間変動に 対応するため、GHT(Gain History Table) を作成
- ・長期成分のモデル化

長期成分の残差分布

unt Number

800

600

400

200

ž

4ksごとに、511 keV対消滅線を フィット (各ユニット、slow/fast)

Long(t) = a + b exp(-t/c) + d exp(-t/e)

W00 の例

-2

0

2

v final addPass.dat



変動の大きなユニットでは、短期変動をモデル化して取り込むことが必要

GSO: ゲイン変動のモデル化(短期成分)

・短期成分のモデル化

PHA(t) = Long(t) { 1 + f(TSAA, NSAA) + g(温度) } f(TSAA, NSAA) = a[NSAA] - b exp (-TSAA / c) g(温度) = d + e x 温度 f(Lage) = d + e x 温度



すべてのユニットで、ゲインを残差 1.5%以内で再現